PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2000-182774

(43) Date of publication of application: 30.06.2000

(51)Int.Cl.

H05B 33/22

H05B 33/14

H05B 33/26

(21)Application number : 10- (71)Applicant : KIDO JUNJI

357899

AIMESU:KK

(22)Date of filing:

16.12.1998 (72)Inventor: KIDO JUNJI

MIZUKAMI TOKIO

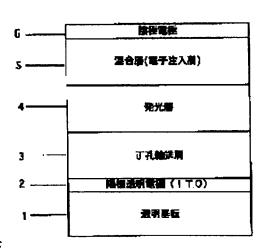
ENDO JUN MORI KOICHI

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic elecroluminescence element capable of using an inexpensive, stable metal usually used as a circuit forming material as a cathode material, with a low energy barrier in electron injection into an organic layer, low driving voltage, high efficiency, and high brightness.

SOLUTION: An organic layer coming in contact with a cathode 6 is formed with a mixture layer 5 comprising an organic metal complex compound containing at least one of an alkali metal ion, an alkali earth metal ion. and a rare earth metal ion, and an electron



transport organic material, and metal capable of reducing the metal ion contained in the organic metal complex compound which is the constituting material of the mixture layer 5 into a metal in vacuum is used as a cathode material.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.10.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-182774 (P2000-182774A)

(43)公開日 平成12年6月30日(2000.6.30)

(51) Int.Cl.'		識別記号	FI			テーマコード(参考)
H05B	33/22		H05B	33/22	Α	3 K O O 7
	33/14			33/14	Α	
	33/26			33/26	Z	

		浆糖查審	未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)
(21)出顯番号	特顧 平10-357899	(71)出願人	597011728
			城戸 淳二
(22)出顧日	平成10年12月16日(1998.12.16)		奈良県北葛城郡広陵町馬見北9-4-3
		(71)出顧人	593191350
			株式会社アイメス
		ļ	神奈川県藤沢市桐原町3番地
		(72)発明者	城戸淳二
			奈良県北葛城郡広陵町馬見北9-4-3
		(72)発明者	水上 時雄
		:	神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア
		İ	イメス内
		(74)代理人	,
		(14)104	サ理士 三浦 邦夫
		ļ	2
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセント素子

(57)【要約】

【課題】 従来から配線材として一般に用いられてきた 安価で安定な金属を陰極材料として用いることができ、 有機層への電子注入におけるエネルギー障壁が小さく、 駆動電圧が低く、高効率、高輝度の有機エレクトロルミ ネッセント素子を提供すること。

【解決手段】 陰極電極6に接する有機層をアルカリ金 属イオン、アルカリ上類金属イオン、希土類金属イオン の少なくとも工種をを含有する有機金属錯体化合物と電 子輸送性有機物とからなる混合層5とし、陰極材料とし て混合層5の構成材料である有機金属錯体化合物中に含 まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属を用 いた有機エレクトロルミネッセント素子。

6 ——	陰極電極
5	混合曆(電子注入曆)
4	発光層
з ——	正孔輸送層
2	陽福透明電福(1T0)
1 —	透明基板

【特許請求の範囲】

【請求項1】 対向する陽極電極と陰極電極の間に、有機化合物から構成される少なくとも一層の発光層を有する有機エレクトロルミネッセント素子において、

上記陰極電極に接する部分の有機層が、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1種を含有する有機金属錯体化合物と電子輸送性有機物との混合層により構成され、目つ、

該陰極電極が、該混合層中の有機金属錯体化合物中に含 行されるアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希上類金属イオンを真空中において金属に還元しう る金属からなることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項2】 請求項1記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、上記混合層が共蒸着により形成される有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項3】 請求項1または2記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、陰極電極に用いる金属がA1、Zr、Tr、Y、Sc及びSiのいずれかである有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項4】 請求項1または2記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、陰極電極に用いる金属がA1、Zr、Ti、Y、Sc及びSiのうちの1種以上を含有する合金である有機エレクトロルミネッセント素子。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【技術分野】本発明は、平面光源や表示素子に利用される 存機エレクトロルミネッセント素子(以下、有機 E L 素子と略す。)に関するものである。

[00002]

【従来の技術およびその問題点】発光層が有機化合物か ら構成される有機上し素子は、低電圧駆動の大面積表示 素子を実現するものとして注目されている。Tangらは素 子の高効率化のため、キャリア輸送性の異なる有機化合 物を積層し、正孔と電子がそれぞれ陽極、陰極よりバラ ンスよく注入される構造とし、しかも有機層の膜厚が20 00Å以下とすることで、10V 以下の印加電圧で1000cd/m - と外部量子効率1%の実用化に十分な高輝度、高効率。 を得ることに成功した(Appl. Phys. Lett., 51,913 (1987)。)。この高効率素子において、Tangらは基本的 40 に絶縁物とみなされる有機化合物に対して、金属電極か ら電子を注入する際に問題となるエネルギー障壁を低下 させるため、仕事関数の小さいMg(マグネシウム)を使 用した。その際、個は酸化しやすく、不安定であるの と、有機表面への接着性に乏しいので、比較的安定でし かも有機表面に密着性の良いAg(銀)と共蒸着により合 金化して用いた。

【00003】凸版印刷株式会社のグループ (第51回応 用物理学会学術講演会、講演予稿集28a-PB-4、p.1040) およびパイオニア株式会社のグループ (第54回応用物 50

理学会学術講演会、講演予稿集29p-2C-15、p.1127)は、Mgより更に仕事関数の小さいLi(リチウム)を用いA1(アルミニウム)と合金化する事により安定化させ陰極として川いることにより、Mg合金を川いた素子より低い駆動電圧と高い発光輝度を達成している。また、本発明者らは有機化合物層上にリチウムを単独で10Å程度に極めて薄く蒸着し、その上から銀を積層した二層型陰極が低駆動電圧の実現に行効であることを報告している

2

(IEEE Trans. Electron Devices., 40, 1342 (199-3))

【0004】最近ではUNIAX 社のPei らが、ポリマー発 光層にリチウム塩をドーピングし、駆動電圧を低下する 事に成功している(Science, 269, 1086 (1995))。こ れは電圧印加によってポリマー発光層中に分散したLi塩 を解離させ、陰極と陽極近傍にそれぞれLiイオンと対イ オンを分布させることにより電極近傍のポリマー分子を in situ でドーピングするものである。この場合、陰極 近傍のポリマーは電子供与性(ドナー)ドーパントであ るLiによって還元されたラジカルアニオン状態で存在す るため、陰極からの電子注人障壁はLiドーピングしない 場合より極めて低くなる (Science, 269, 1086 (1995))。さらに、最近では本発明者らはリチウムなどのア ルカリ金属、ストロンチウムなどのアルカリ土類金属、 サマリウムなどの希土類金属を陰極に接する有機層中に ドーピングすることにより、駆動電圧を低下させること に成功した(SID97DIGEST・P775)。これは電極に接する 有機層を金属ドーピングによりラジカルアニオン状態と し、陰極からの電子注入障壁を大幅に低下させたためと 考えられる。

【0005】しかしながら、NgやLiの合金電極においても電極の酸化等による素子劣化が起こる上、配線材料としての機能を考慮しなければならないので、合金電極では電極材料選択において制限を受ける。本発明者らの二層型陰極では、Li層の厚みが20Å以上では陰極機能しないうえ(IEEE Trans. Electron Devices... 40, 1342(1993))、極めて薄い10Å程度のLiの蒸着は膜厚制御が困難であり素子作製の再現性に問題がある。また、Peiらの発光層中に塩を添加して電界にて解離させるin situドーピング法では、解離したイオンの電極近傍までの移動時間が律速となり、素子応答速度が著しく遅くなる欠点がある。有機層を金属でドーピングする方法においては、ドーピング濃度が素子特性に影響を及ぼすので、有機層成膜時にドーパント濃度の精密制御が必要である。

[0006]

30

【発明の目的】本発明は、以上の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は簡便かつ確実な方法で陰極から 有機化合物層への電子注入におけるエネルギー障壁を低 下させることにより、陰極材料の仕事関数に拘わらず低 駆動電圧を実現することである。本発明の他の目的は、 A1の様な従来より配線材として一般に用いられてきた安 価で安定な金属を陰極材料として単独で用いた場合でも、上述の合金を電極として用いた場合と同様、若しくはそれ以上の特性を発見しうる素子を提供することである。

[0007]

【発明の概要】すなわち、本発明は、対向する陽極電極と陰極電極の間に、有機化合物から構成される少なくとも一層の発光層を有する有機正し素子において、上記陰極電極に接する部分の有機層が、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1種を含有する有機金属錯体化合物と電子輸送性有機物との混合層により構成され、且つ、該陰極電極が、該混合層中の有機金属錯体化合物中に含有されるアルカリ金属イオン、アルカリ上類金属イオン、希土類金属イオンを真空中において金属に還元しうる金属からなることを特徴としている。

【0008】陰極電極に用いる金属としては、陰極に接する有機層(以下、電子注入層)を構成する有機金属錯体化合物に含まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属であれば、特に制限はないが、例えば、A1、Z1、Ti、Y、Sc及びSiなどが好ましい。陰極は、これらの金属単独からなるものであっても、A1、Zr、Ti、Y、Sc及びSiなどの金属のうちの一種又は複数種を含有する合金からなるものであってもよい。上記のような金属及びその合金は、高融点であって、真空中で有機金属錯体化合物中の金属イオンを金属に選元することができる

【0009】一般にアルカリ金属、アルカリ土類金属、希上類金属の一部は、高融点金属のA1等に比べ、高い飽和蒸気圧を示し、酸化、還元反応の起こるような反応温 30度において、高融点金属であるA1、S1、Zr等でその化合物を還元できることが知られている。たとえば、酸化カルシウムはアルミニウムによって還元され金属カルシウムが遊離し(化学便覧、応用化学編1、P369)、酸化ルビジウム(金属便覧、P88)や酸化ストロンチウム(金属便覧、P89)もアルミニウムによって還元され金属ルビジウムや金属ストロンチウムが遊離することが知られている。

【0010】有機EL素子における金属電極の作製は、10% torr以下の真空中で行なわれ、基板上には溶融、揮 40 発後の原子状金属が到達する。したがって、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物、希上類金属化合物に、AI、Si、左等の熱環元性を有する金属が原子状で作用すると、前記の例にある真空下での還元反応により金属化合物から、金属を選元、遊離させることが可能である。この時、電子注入層が該有機金属錯体化合物と電子輸送性有機物との混合層であれば有機金属錯体化合物より還元、遊離したアルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属が隣接する電子輸送性有機物を効率的に還元し、金属ドーピング層を形成する。 50

【0011】 還元されるアルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物、希土類金属化合物が酸化物や弗化物等の無機化合物である場合は、その高い安定性の故に蒸発温度が高く、電子輸送性有機物との共蒸着が困難である場合がある。また、その高い絶縁性のために、還元されずに残存している分子が素子の駆動電圧を上昇させることが予想される。

【0012】本発明は、以上の事情に鑑みてなされたものであり、アルカリ金属化合物、アルカリ土類金属化合物、 アルカリ土類金属化合物、 希土類金属化合物を無機化合物ではなく有機金属錯体化合物とし、電子輸送性有機物と共蒸着により両者を混合し混合層として形成した後、この混合層の上に、有機金属錯体化合物に含まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属を陰極として使用した場合に、 該降極金属の真空中での還元力を利用して、 有機金属錯体化合物から還元された金属を遊離させ、 さらにその遊離金属で隣接する電子輸送性有機物を還元することにより、 電子注入障壁を小さくし、 駆動電圧を低下させることに成功したものである。

【0013】本発明において、電子注入層の構成分子で ある有機金属鉛体化合物としては、アルカリ金属イオ ン、アルカリ土類金属イオン、希土類金属イオンの少な くとも1種を含有する有機金属鉛体化合物から構成し、 陰極材料としては、電子注入層の構成材料である有機金 屈錯体化合物に含まれる金属イオンを真空中で金属に選 元しうる金属を使用し、このような金属の真空中での選 元力を利用して、有機金属錯体化合物の金属を遊離さ せ、さらにその遊離金属で有機化合物を還元することに より、電子注入障壁を小さくし、駆動電圧を低下させる ことに成功したものである。本発明において、電子注入 層に使用される有機金属錯体化合物としては、金属イオ ンとしてアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオ ン、希上類金属イオンの少なくとも一種を含有するもの であれば特に限定はない。また配位子にはキノリノー ル、ベンゾキノリノール、アクリジノール、フェナント リジノール、ヒドロキシフェニルオキサゾール、ヒドロ キシフェニルチアゾール、ヒドロキシジアリールオキサ ジアゾール、ヒドロキシジアリールチアジアゾール、ヒ ドロキシフェニルピリジン、ヒドロキシフェニルベンゾ イミダゾール、ヒドロキシベンゾトリアゾール、ヒドロ キシフルボラン、ビピリジル、フェナントロリン、フタ ロシアニン、ポルフィリン、シクロペンタジエン、β-ジケトン類、アゾメチン類、およびそれらの誘導体など が好ましいが、これらに限定されるものではない。

[0014]

【発明実施の形態】図 1 は、本発明による有機 E L 素子の一実施形態を示す模式図である。ガラス基板(透明基板) 1 上には、頃に、陽橋電極を構成する透明電極 2、正孔輸送性を有する正孔輸送暦 3、発光層 4、電子注人層(混合層)5(有機層)、および陰極電極 6 を積層し

物、例えばトリス(8-キノリノラト)アルミニウム、ビ ス(8-キノリノラト)マグネシウム、ビス [ベンゾ(f) -8- キノリノラト] 亜鉛、ビス(2-メチル-8- キノ リノラト)アルミニウム、トリス(8-キノリノラト)イ ンジウム、トリス (5-メチル-8- キノリノラト) アルミ ニウム、8-キノリノラトリチウム、トリス(5-クロロ-8

- キノリノラト) ガリウム、ビス(5-クロロ-8- キノリ ノラト) カルシウムなどの8-キノリノラトあるいはその 誘導体を配位子として少なくとも一つ有する金属錯体が 好適に使用される。

【0019】特開平5-202011号公報、特開平7-179394号 公報、特開平7-278124号公報、特開平7-228579号公報に 開示されているオキサジアゾール類、特開平7-157473号 公報に開示されているトリアジン類、特開平6-203963号 公報に開示されているスチルベン誘導体およびジスチリ ルアリーレン誘導体、特開平6-132080号公報や特開平6-88072 号公報に開示されているスチリル誘導体、特開平

6-100857号公報や特開平6-207170号公報に開示されてい るジオレフィン誘導体も発光層や電子輸送層として好ま LIN

【0020】さらに、ベンゾオキサゾール系、ベンゾチ アゾール系、ベンゾイミダゾール系などの蛍光増白剤も 使用でき、例えば、特開昭59-194393 号公報に開示され ているものが挙げられる。その代表例としては、2.5-ビ ス (5.7-ジ-ι- ペンチル-2-ベンゾオキサゾリル) -1.3. 4- チアジアゾール、4.4 - ビス(5.7-t-ペンチル-2-ベンゾオキサゾリル)スチルベン、4.4 - ビス [5.7-ジ - (2-メチル-2- ブチル) -2- ベンゾオキサゾリル] ス チルベン、2.5-ビス(5.7-ジ-t-ペンチル-2-ベンソオ キサゾリル) チオフェン、2.5-ビス [5-(α.α-ジメ チルベンジル)-2-ベンゾオキサゾリル]チオフェン、 2.5-ビス [5.7-ジ- (2.メチル-2- ブチル) -2- ベンゾ オキサゾリル]-3.4-ジフェニルチオフェン、2.5-ビス (5-メチル-2- ベンゾオキサゾリル) チオフェン、4.4 - ビス (2-ベンゾオキサゾリル) ビフェニル、5-メチル -2- {2- {4- (5-メチル-2- ベンゾオキサゾリル) フェ ニル] ビニル} ベンゾオキサゾール、2- [2-(4-クロロ フェニル) ビニル] ナフト (1.2-d)オキサゾールなどの ベンゾオキサゾール系、2,2 -(p-フェニレンジピニレ ン)-ビスペンゾチアゾールなどのベンゾチアゾール系、 2- {2- {4- (2-ベンゾイミダゾリル) フェニル) ビニ

ル) ベンゾイミダゾール、2- [2-(4-カルボキシフェニ ル) ビニル] ベンゾイミダゾールなどのベンゾイミダゾ ール系などの蛍光増白剤が挙げられる。

【0021】ジスチリルベンゼン系化合物としては、例 えば欧州特許第0373582 号明細書に開示されているもの を川いることができる。その代表例としては、1.4-ビス (2-メチルスチリル) ベンゼン、1,4-ビス (3-メチルス チリル) ベンゼン、1,4-ビス(4-メチルスチリル)ベン

てなっている。これらの要素(層)のうち、ガラス基板 (透明基板) 1 、透明電極 2 、正孔輸送層 3 、および発 光層 4 は周知の要素であり、電子注入層(混合層)5 お よび除極電極6が本発明で提案した特徴を有するもので ある。有機EL素子の具体的な積層構成としては、この 他、陽極三発光層/電子注人層(混合層)/陰極、陽極 **/正孔輸送層/発光層/電子注入層(混合層)/陰極、** 陽極。正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層 (混合層) /陰極、陽極/正孔注入層/発光層/電子注 天層(混合層)/陰極、陽極/正孔注入層/正孔輸送層 10 -/ 発光層/電子往入層(混合層)/ 陰極、極/正孔注入 層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層(混 合層) / 陰極、などが挙げられるが、本発明による有機 E1素子は、電子注入層(混合層)5と陰極電極6の材 料の組み合わせが本発明の前記の条件を満たすのあれば いかなる素子構成であっても良い。

【0015】上記、電子注入層(混合層)5の成膜法 は、有機金属錯体化合物と電子輸送性有機物が均一に混 合されれば、いかなる薄膜形成法であってもよく、たと えば蒸着法やスパッタ法が使用できる。また、溶液から 20 の塗布で薄膜形成が可能な場合には、スピンコーティン グ法、ディップコーティング法、インクジェット法など の溶液からの塗布法が使用できる。

【0016】また、上記陰極電極6の成膜法は、蒸着法 やスパッタ法が使用できるが、真空中における成膜法で あればそれに限定されるものではない。

【()() 1.7】電子注入層(混合層)の電子輸送性有機 物、発光層及び電子輸送層として使用できる有機化合物 としては、特に限定はないが、p-テルフェニルやクアテ ルフェニルなどの多環化合物およびそれらの誘導体、ナ 30 フタレン、テトラセン、ピレン、コロネン、クリセン、 アントラセン、ジフェニルアントラセン、ナフタセン、 フェナントレンなどの縮合多環炭化水素化合物及びそれ らの誘導体、フェナントロリン、パソフェナントロリ ン、フェナントリジン、アクリジン、キノリン、キノキ サリン、フェナジンなどの縮合複素環化合物およびそれ らの誘導体や、フルオレセイン、ペリレン、フタロペリ レン、ナフタロペリレン、ベリノン、フタロペリノン、 ナフタロベリノン、ジフェニルブタジエン、テトラフェ ニルブタジエン、オキサジアゾール、アルダジン、ビス 40 ベンゾキサゾリン、ピススチリル、ピラジン、シクロペ ンタジエン、オキシン、アミノキノリン、イミン、ジフ ェニルエチレン、ビニルアントラセン、ジアミノカルバ ゾール、ピラン、チオピラン、ポリメチン、メロシアニ ン、キナクリドン、ルブレン等およびそれらの誘導体な どを挙げることができる。

【0018】また、特別昭63-295695 号公報、特別平8-22557 号公報、特開平8-81472 号公報、特開平5-9470号 公報、特別平5-17764 号公報に開示されている金属キレ ---ト鉛体化合物、特に金属キレート化オキサノイド化合 so ゼン、ジスチリルベンゼン、1.4-ビス(2-エチルスチリ

ル) ベンゼン、1.4-ビス (3-エチルスチリル) ベンゼン、1.4-ビス (2-メチルスチリル) -2- メチルベンゼン、1.4-ビス (2-メチルスチリル) -2- エチルベンゼンなどが挙げられる。

【0022】また、特開平2-252793号公報に開示されているジスチリルビラジン誘導体も発光層、電子輸送層として用いることができる。その代表例としては、2.5-ビス(4-メチルスチリル)ピラジン、2.5-ビス(4-エチルスチリル)ピラジン、2.5-ビス(4-メトキシスチリル)ピラジン、2.5-ビス(2-(1-ナフチル)ピラジン、2.5-ビス[2-(4-ビフェニル)ビニル]ピラジン、2.5-ビス[2-(1-ピレニル)ビニル]ピラジンなどが挙げられる。

【0023】その他、欧州特許第388768号明細書や特開 平3-231970号公報に開示されているジメチリディン誘導 体を発光層や電子輸送層の材料として用いることもでき る。その代表例としては、1.4-フェニレンジメチリディ ン、4.4 - フェニレンジメチリディン、2.5-キシリレン ジメチリディン、2,6-ナフチレンジメチリディン、1.4-ビフェニレンジメチリディン、1.4-p-テレフェニレンジ 20 メチリディン、9.10 アントラセンジイルジメチリディ ン、4.4 - (2.2- ジ-1・ブチルフェニルビニル) ビフェ ニル、4.4 -(2.2-ジフェニルビニル) ビフェニル、な ど、及びこれらの誘導体や、特開平6-49079 号公報、特 開平6-293778号公報に開示されているシラナミン誘導 体、特開平6-279322号公報、特開平6-279323号公報に開 示されている多官能スチリル化合物、特開平6-107648号 公報や特開平6-92947 号公報に開示されているオキサジ アゾール誘導体、特開平6-206865号公報に開示されてい るアントラセン化合物、特開平6-145146号公報に開示さ 30 れているオキシネイト誘導体、特別平4-96990 号公報に 開示されているテトラフェニルブタジエン化合物、特開 平3-296595号公報に開示されている有機三官能化合物、 さらには、特開平2-191694号公報に開示されているクマ リン誘導体、特開平2-196885号公報に開示されているペ リレン誘導体、特開平2-255789号に開示されているナフ タレン誘導体、特開平2-289676号及び特開平2-88689 号 公報に開示されているフタロペリノン誘導体、特開平2-250292号公報に開示されているスチリルアミン誘導体な どが挙げられる。さらに、従来有機EL素子の作製に使 40 川されている公知のものを適宜用いることができる。

【0024】正孔注入層、正孔輸送層、正孔輸送性発光 層として便用されるアリールアミン化合物類としては、 特に限定はないが、特開平6-25659 号公報、特開平7-145116号 公報、特開平7-224012号公報、特開平7-157473号公報、 特別平8-48656 号公報、特開平7-126226号公報、特開平 7-188130号公報、特開平8-40995 号公報、特開平8-4099 6 号公報、特開平8-40997 号公報、特開平7-126225号公報、特開平7-101911号公報、特開平7-97355 号公報に開 so

示されているアリールアミン化合物類が好ましく、例え ば、N.N.N.N.テトラフェニル-4.4 -ジアミノフェニ ル、N.N - ジフェニル-N.N -ジ(3-メチルフェニル) -4.4 -ジアミノビフェニル、2.2-ビス(4-ジ-p- トリル アミノフェニル) プロパン、N.N.N .N -テトラ-p- トリ ル-4,4 -ジアミノビフェニル、ビス(4-ジ-p- トリルア ミノフェニル)フェニルメタン、N.N - ジフェニル-N. N -ジ (4-メトキシフェニル) -4.4 -ジアミノビフェニ ル、N,N,N ,N -テトラフェニル-4,4 -ジアミノジフェニ ルエーテル、4.4 - ビス(ジフェニルアミノ)クオード リフェニル、4-K.N-ジフェニルアミノ- (2-ジフェニル ビニル) ベンゼン、3-メトキシ-4 -N.N-ジフェニルアミ ノスチルベンゼン、N-フェニルカルバゾール、1,1-ビス (4- ジ-p- トリアミノフェニル) - シクロヘキサン、 1.1-ビス(4-ジ-p-トリアミノフェニル)-4- フェニル シクロヘキサン、ビス(4-ジメチルアミノ-2-メチルフ ェニル) - フェニルメタン、N.N.N-トリ(p-トリル)ア ミン、4- (ジ-p- トリルアミノ) -4 - [4 (ジ-p- トリ ルアミノ) スチリル] スチルベン、N.N.N .N -テトラフ ェニル-4.4 -シアミノ- ビフェニルN-フェニルカルバゾ ール、1,1 - ビス [N-(1-ナフチル) -N- フェニル- ア ミノ] ビフェニル、4.4 -ビス [N-(1-ナフチル)-N-フェニル- アミノ] p-ターフェニル、4.4 - ビス [N-(2-ナフチル) -N- フェニル- アミノ] ビフェニル、4. 4 - ビス [N-(3-アセナフテニル) -N- フェニル- アミ ノ] ビフェニル、1,5-ビス [N-(1-ナフチル)-N-フェ ニル- アミノ] ナフタレン、4.4 - ビス [N-(9-アント リル) -N- フェニル- アミノ] ビフェニル、4.4 -ビス [N- (1-アントリル) -N- フェニル- アミノ] p-ターフ ェニル、4.4 - ビス [N-(2-フェナントリル) -N-フェ ニル- アミノ] ビフェニル、4.4 - ビス [N-(8-フルオ ランテニル) -N- フェニル- アミノ] ビフェニル、4.4 - ビス [N-(2-ピレニル) -N- フェニル- アミノ] ビフ ェニル、4.4 - ビス [N- (2-ペリレニル) -N- フェニル - アミノ] ビフェニル、4.4 -ビス [N- (1-コロネニ ル) -N- フェニル- アミノ] ビフェニル、2.6-ビス(ジ -p- トリルアミノ) ナフタレン、2.6-ビス [ジ- (1-ナ フチル) アミノ] ナフタレン、2.6-ビス [N-(1-ナフチ ル) -N- (2-ナフチル) アミノ] ナフタレン、4.4 -ビ ス [N,N-ジ(2-ナフチル) アミノ] ターフェニル、4.4 - ビス {N-フェニル-N- [4-(1-ナフチル) フェニル] アミノ) ビフェニル、4.4 - ビス [N-フェニル-N- (2-ピレニル) - アミノ] ビフェニル、2.6-ビス [N,N-ジ (2-ナフチル) アミノ] フルオレン、4.4 - ビス (N. N-ジ-p- トリルアミノ) ターフェニル、ビス (N-1-ナフ チル) (N-2-ナフチル) アミンなどがある。さらに、従 来有機EL素子の作製に使用されている公知のものを適 宜用いることができる

8

【0025】さらに、正孔注入層、正孔輸送層、正孔輸送性発光層として、上述の有機化合物をポリマー中に分

散したものや、ポリマー化したものも使用できる。ポリパラフェニレンビニレンやその誘導体などのいわゆるπ 共役ポリマー、ポリ(N-ビニルカルバゾール)に代表されるホール輸送性非共役ポリマー、ポリシラン類のシグマ共役ポリマーも用いることができる。

【0026】ITO (インジウム-スズ酸化物) 電極 (陽極電極) 上に形成する正孔注入層としては、特に限定はないが、銅フタロシアニンなどの金属フタロシアニン類および無金属フタロシアニン類、カーボン膜、ポリアニリンなどの導電性ポリマーが好適に使用できる。さらに、前述のアリールアミン類に酸化剤としてルイス酸を作用させ、ラジカルカチオンを形成させて正孔注入層として用いることもできる。

【0027】 [実施例] 以下に実施例を挙げて本発明を 説明するが、本発明はこれにより限定されるものではない。なお、有機化合物および金属の蒸着には、真空機工 社製VPC-400 真空蒸着機を使用した。膜厚の測定はスローン社製DekTak3ST 触針式段差計を用いた。素子の特性評価には、ケースレー社ソースメータ2400、トプコンBM-8輝度計を使用した。素子のITO を陽極、AIを陰極として直流電圧を IV / 2 秒の割合でステップ状に印加し、電圧上昇1 秒後の輝度および電流値を測定した。また、ELスペクトルは浜松ホトニクスPMA-10オプチカルマルチチャンネルアナライザーを使用して定電流駆動し測定し

10

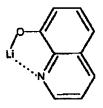
【0028】実施例1

図1の積層構成の有機 E L 素子に本発明を適用したものである。ガラス基板 1 上に陽極透明電極 2 として、シート抵抗25Ω/□の1T0 (インジウム-スズ酸化物、三容真空社製スパッタ蒸着品)がコートされている。その上に正孔輸送性を行する下記式:

で表わされる a NPD を10⁻⁶ torr下で、2 Å/秒の蒸着速度で500 Åの厚さに成膜し、正孔輸送層3を形成した。 次に、前記正孔輸送層3の上に、発光層4として緑色発 30 光を存する下記式:

で表されるトリス(8 キノリノラト)アルミニウム錯体層(以下「Alq」という)を正孔輸送層3と同じ条件で650人の厚さに真空蒸着して形成した。次に、前記発光層4の上に、電子注入層5を混合層とするため、有機金属組体化合物として下記式:

【化3】



で表わされるモノ(8-キノリノラト)リチウム鉛体(以下「Liq」という)を、電子輸送性有機物としてA1qを選び、10-6 torrの真空下で、そが比率 Liq: A1q=1:1で共蒸着し、50Åの厚さに成膜した。最後に、前記電子注入層(混合層)5の上に、陰極電極6としてA1を蒸着速度10Å/秒で1000Å蒸着した。発光領域は縦0.5cm、横0.5cmの正方形状とした。前記の有機EL素子において、陽極透明電極2であるITOと陰極電極6であるA1との間に、直流電流を印加し、発光層4(A1q)から緑色発光の輝度を測定した。図2中の自丸プロットはこの素子の輝度-電圧特性を示すもので、最高27,500cd/m²の高輝度を11Vにおいて示した。また1,000cd/m²の 卸度は6.5Vで得られた。

【0029】比較例1

実施例1と同じく、170 上にまず正孔輸送層としてαNP D を500 Åの厚さに成膜し、その上に、発光層としてA1 a を正孔輸送層と同じ条件で700 Åの厚さに真空蒸着し

12

て形成した。さらに、電子注入層として前記Liqを 1 Å / 秒の蒸着速度で 5 Å の厚さに成膜した。そして、Liq の上から陰極としてA1を1,000 Å 蒸着した。図 2 中の黒 九プロットはこの素子の輝度 - 電圧特性を示すものであり、13V で最高21000cd/㎡の輝度を与えた。また1,000 cd/㎡の輝度を得るのに 9.5 V 印加する必要があった。

【0.0.3.0】この実験から駆動電圧を下げるのに電子注 入層(混合層)5.0ような混合層が有効であることがわ かる。

【0031】実施例2

170 上に、正孔輸送層 3 として α NPD を500 Å、発光層 4 として Δ Iq を400 Å の厚さに真空蒸着した後、実施例 1 と同様の条件でLiqと Δ Iqの電子注入層(混合層) 5 を 300 Å の厚さに成膜した。その上から、陰極電極 6 として Δ Iを 1000 Å 蒸着し素子を作製した。この素子は印加電圧 1 4 V で最高調度 19 .000 cd/m² を与えた。また1,000 cd/m² の輝度を得るのに 1 0 V 印加する必要があった。実 施例 1 と比較すると素子特性は若干低下したが混合層を厚くしても、上記比較例 1 とほぼ同様の特性をえた。

【0032】比較例2

実施例2と同じく、ITO 上にまず正孔輸送層として a NP D を500 Åの厚さに成膜し、その上に、発光層としてA1 q を400 Åの厚さに真空蒸着した後、無機化合物であるL iTとA1qを10⁶ torrの真空下で、そ此率 LiF: A1q= 1:1で共蒸着し、300 Åの厚さに成膜した。その上から、陰極電極6としてA1を1000 Å蒸着し素子を作製した。この素子は印加電圧17Vで最高輝度7.300cd/m²を与えた。また1,000cd/m²の輝度を得るのに15.5V 印加する必要があった。実施例2と比較すると、還元されず 30

に混合層中に残存しているLiFのような電気絶縁性の無機化合物は、有機金属錯体化合物と比較して、素子の特性を大きく低下させることが分かった。

[0033]

【発明の効果】本発明は、陰極に接する有機層(電子注入層)をアルカリ金属イオン、アルカリ上類金属イオン、希土類金属イオンの少なくとも1種を含有する金属錯体化合物と電子輸送性有機物との混合層とし、その金属錯体化合物中に含まれる金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属を陰極材料として使用することによって、従来から配線材として一般に用いられてきた安価で安定な金属を陰極材料として用いることができ、しかも電子注入障壁を小さくし、駆動電圧が低く、高効率、高輝度の有機EL素子の作製を可能にしたものである。したがって、本発明の有機EL素子は実用性が高く、表示素子や光源としての有効利用が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機EL素子の積層構造例を示す模式 断面図である。

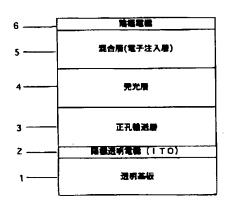
「図2】本発明の有機EI上素子と比較例の輝度-電圧特性を示すグラフ図である。

【図3】本発明の有機 E.1.素子と比較例の輝度一電圧特性を示すグラフ図である。

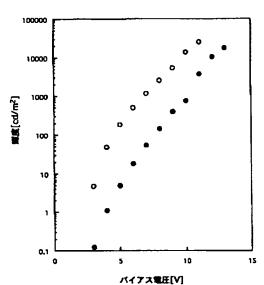
【符号の説明】

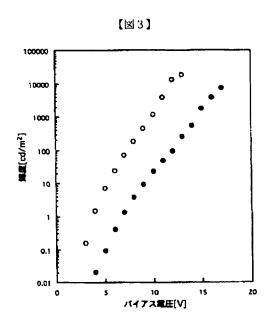
- 1 透明基板
- 2 陽極透明基板
- 3 正孔輸送層
- 4 発光層
- 5 電子注入層(混合層)
- 6 陰極電極

[図1]



【図2】





フロントページの続き

(72)発明者 遠藤 潤 神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社ア イメス内 (72)発明者 森 浩一 神奈川県藤沢市桐原町 3 番地 株式会社ア イメス内

F ターム(参考) 3K007 AB02 AB03 AB06 CA01 CB01 DA00 DB03 EB00 FA01 FA03